

2019 часть 1

з84 А22 Advances in Semiconductor Nanostructures / Ed. by A.V. Latyshev, A.V. Dvurechenskii, A.L. Aseev. - Amsterdam [et al.] : Elsevier, 2017. - 528 с.

з84 I69 International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM 2019)(20th ; 29 June - 3 July, 2019 ; Erlagol, Altai Republic) : Proceedings / Organizer Novosibirsk State Technical University. - Novosibirsk : NSTU, 2019. - 786 с.

В379 А437 Актуальные проблемы физики полупроводников: наноструктуры, эпитаксия, фотоника и электроника : научные результаты ИФП СО РАН за 2018 год / под ред. акад. А.В. Латышева ; Минобрнауки России, Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН. - Новосибирск : Параллель, 2019. - 255 с.

з84 В68 Володин В.А. Физические основы микроэлектроники: лекции и задачи : учеб. пособие / В.А. Володин, А.А. Блошкин ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2019. - 214 с.

В3 Д384 Детонационные наноалмазы. Технология, структура, свойства и применения / под ред. А.Я. Вуля, О.А. Шендеровой. - СПб. : Изд-во ФТИ им. А.Ф. Иоффе, 2016. - 105 с.

В3 И712 Институт автоматизации и электрометрии в 2018 году. Отчет о деятельности / отв. за вып. уч. секретарь Е.И. Донцова ; Минобрнауки России. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2019. - 132 с.

К63 Организатор Ин-т физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН [и др.]. Комбинационное рассеяние - 90 лет исследований : Российская конф. и школа молодых ученых по актуальным проблемам спектроскопии комбинационного рассеяния света (с участием иностранных ученых)(28 мая-1 июня, 2018 ; Новосибирск) : тезисы докладов. - Новосибирск : ИПЦ НГУ., 2018. - 162 с.

В379 Р763 Российская конференция по физике полупроводников (XIV ; 9-13 сентября, 2019 ; Новосибирск) : тезисы докладов / организатор Ин-т физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН [и др.]. Часть 2. - М. : Перо, 2019. - 270 с.

В379 Р763 Российская конференция по физике полупроводников (XIV ; 9-13 сентября, 2019 ; Новосибирск) : тезисы докладов / организатор Ин-т физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН [и др.]. Часть 1. - М. : Перо, 2019. - 272 с.

В3 Ф504 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе. Краткая история в фотографиях и документах. Книга I. Эпоха Иоффе * 1918 - 1950 / гл. ред. А.П. Шергин. - СПб. : Изд-во ФТИ им. А.Ф. Иоффе, 2018. - 212 с.

з85 Ф815 Фотоника 2019 : Российская конф. по актуальным проблемам полупроводниковой фотозлектроники (с участием иностранных ученых)(27-31 мая, 2019 ; Новосибирск) : тезисы докладов / организатор Ин-т физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН. - Новосибирск : ООО "Офсет-ТМ", 2019. - 195 с.

Г Щ334 Щеглов Д.В.[и др.] Кремниевая метрология в развитии нанотехнологий / Д.В. Щеглов, Л.И. Федина, А.В. Латышев. - Новосибирск : Параллель, 2018. - 184 с.